

# 用于BESIII 内径迹室的圆筒 GEM探测器的研制

董明义

On behalf of the IHEP and Italy CGEM collaboration group

核探测与核电子学国家重点实验室 中科院高能物理研究所

2015.7.24



# Outline

CGEM 探测器的制作 CGEM电极、阴极、阳极
束流测试
读出电子学芯片设计
与北京谱仪接口的初步设计

◆ 总结



# CGEM作为BESIII内径迹室升级方案

采用3层CGEM探测器替换漂移室内室,第二层探测器可以直接使用 KLOE2的mold,建造从第二层开始

### THE CGEM-IT





#### Requirements

Rate capability: ~10 KHz/cm<sup>2</sup> Spatial resolution:  $\sigma_{xy} \approx 100 \mu m$ :  $\sigma_z \approx 1mm$ Momentum resolution (INNER+MDC):  $\sigma_{pt}/P_t \approx 0.5\%$  @1GeV Efficiency = ~98% Material budget  $\leq 1.5\%$  all layers Coverage: 93% 4 $\pi$ 

#### Three active layers

- Active area
  - LI length 532 mm
  - L2 length: 690 mm
  - L3 length: 847 mm
- Inner radius: 78 mm
- Outer radius: 178 mm



# CGEM作为BESIII内径迹室

- ◆ 根据模拟结果,选用更低物质量的阴极和阳极支撑材料,
   rohacell(聚甲基丙烯酰亚胺硬质泡沫)代替honeycomb,单 层探测器的物质量由0.49%减小到0.33% X<sub>0</sub>
- ◆ XV阳极读出条结构
- ◆ 为了实现更好的位置分辨,采用模拟读出电子学
- ◆ 尽量利用KLOE2的mold工装,降低成本





# 首个BESIII-CGEM探测器CGEM电极: GEM测试





氮气环境下的高压测试

# 首个BESIII-CGEM探测器CGEM 电极: CGEM制作1



利用真空技术将2片GEM膜粘接成一张平板电极,尺寸为700×860mm<sup>2</sup>

交叠处涂胶



框架涂胶

#### 合拢到圆桶模具上,利用真空技术粘接



#### 完成了第二层GEM探测器的3个CGEM电极,打包以待最后组装



#### 制作完成后在空气中进行的新一轮高压测试 (<1nA@300V)







### 首个BESIII-CGEM模型的研制: 阴极

Cathode	创新点		BESIII	KLOF-2
12.5 µm Kapton		# of X <sub>0</sub> for 1 layer	0.33	0.49
I mm ROHACELL		# of $X_0$ for 3 layers	0.99	1.47

12.5  $\mu$  kapton foil around the Al mold;

Rohacell plane is glued on the kapton.



Cathode rolled on the rohacell



Cathode ready



### ◆ 2014.12束流测试

- ▶ 验证1T磁场下的模拟读出性能
- ▶ 验证Garfield模拟结果
- > 测试不同结构及不同工作气体下探测器的性能
  - Ar /CO<sub>2</sub>(70/30); Ar /C<sub>4</sub>H<sub>10</sub>(90/10)
  - Two layouts: 5/2/2/2 mm, 3/2/2/2mm
- ◆ 2015年束流测试
  - ▶ 测试"jagged"阳极





### 探测器模型在磁场下,前后各设置两个寻迹室体



模型有效面积: 10x10 cm<sup>2</sup>



X,Y or V条读出, pitch :650µm APV25 芯片

**IHEP** 



### 束流测试初步结果(1): XY-条读出结构Vs 无磁场





### 速流测试初步结果(2): XY-条读出结构Vs有磁场





### 速流测试初步结果(3): XV-条读出结构Vs无磁场





## 读出电子学芯片设计

### 前端

◆ 后端

- 前放第一版基于NMOS,噪声较大
- > 第二版基于PMOS为了降低噪声
  - ◆ 模拟结果<2000 e rms for 150pF@1mA of input current, 本月完成layout

▶ 在已有的芯片上进行优化,基于

计,今年底提交

TOT技术,已完成基准电压源等设



Preamplifier Schematic



Layout of the BandGAP

14



## CGEM与BESIII的接口初步设计

- ◆ 改造对撞区的束流管支撑架,使其固定CGEM探测器和束流管
- ◆ 探测器的高压和信号电缆在东西端各分4个扇区,按扇区引出到 谱仪1层和3层电子学平台
- ◆ 探测器的气体可以利用现在漂移室内室的8路气管







# 软件进展

### 模拟

- Geant4-based full simulation
- Garfield simulation
- Digitization
- ▶ 重建
  - CGEM cluster reconstruction
  - Kalman track fit
  - CGEM tracking
    - CGEM track segment finding
    - Track finding combining CGEM and outer MDC
- ◆ 校准和刻度 (next to do)

Efficiency with different cuts(n = 3, 4, 5)







# 总结

- ◆中意双方合作开展了用于BESⅢ内径迹室的 CGEM探测器的研制,已完成了第二层GEM探测 器GEM电极及阴极的制作和测试
- 进行了平面探测器模型的束流测试,验证了不同 探测器结构、工作气体及阳极结构在磁场下的性 能
- ◆ 该项目计划2017年完成探测器的研制、测试以及 在高能所的调试

